


	<h2>SIA400EDJ-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIA400EDJ-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 12A SC-70</p> <p>Datenblätter:  SIA400EDJ-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 15868 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIA400EDJ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 12A SC-70
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	15868 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 12A (Tc) 3.5W (Ta), 19.2W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Single
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 19.2W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	19 mOhm @ 11A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1265pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIA400EDJ-T1-GE3-ND

SIA400EDJ-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIA400EDJ-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIA400EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIA400EDJ-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIA2206E02-HO SAMSUNG SAMSUNG DIP</p>	 <p>SIA408DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 4.5A SC70-6</p>	 <p>SIA402DJ-T1-E3 VISHAY SIA402DJ-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIA106DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 60V POWERPAK SC-70</p>
 <p>SIA110DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK SC-7</p>	 <p>SIA3223-R15M DELTA DELTA 3223</p>	 <p>SIA3329-8R2K DELTA DELTA 3229-8R2K</p>	 <p>SIA406DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 12V 4.5A SC-70-6</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SIA400EDJ-T1-GE3	↔ SIA402DJ-T1-E3	⇒ SIA406DJ-T1-GE3	D SIA406DJ-T1-GE3	↔ SIA408DJ-T1-GE3
⊣ SIA408DJ-T1-GE3	⊛ SIA411DJ-T1-GE3	D SIA411DJ-T1-GE3	⇒ SIA413DJ-T1-GE3	↔ SIA413DJ-T1-GE3
⊛ SIA413DJ-T4-GE3	⊣ SIA414DJ-T1-GE3	⊛ SIA414DJ-T1-GE3	↔ SIA415DJ-T1-GE3	↔ SIA415DJ-T1-GE3
D SIA417DJ-T1-GE3	⊛ SIA417DJ-T1-GE3	⊣ SIA419DJ	⊛ SIA419DJ-T1-GE3	↔ SIA419DJ-T1-GE3
⇒ SIA421DJ-T1-GE3	↔ SIA421DJ-T1-GE3	⊛ SIA425EDJ-T1-GE3	⊣ SIA425EDJ-T1-GE3	↔ SIA426DJ-T1-GE3
↔ SIA426DJ-T1-GE3	⇒ SIA427DJ-T1-GE3	D SIA427DJ-T1-GE3	⊛ SIA429DJ-T1-GE3	⊣ SIA429DJ-T1-GE3
⊛ SIA430DJ-T1-GE3	D SIA430DJ-T1-GE3	⇒ SIA431DJ	↔ SIA431DJ-T1	↔ SIA431DJ-T1-GE3
⊣ SIA431DJ-T1-GE3	⊛ SIA432DJ-T1-GE3	↔ SIA432DJ-T1-GE3	⇒ SIA433EDJ	↔ SIA433EDJ-T1-GE3
⊛ SIA433EDJ-T1-GE3	⊣ SIA436DJ-T1-GE3	⊛ SIA436DJ-T1-GE3	D SIA443DJ-T1-GE3	↔ SIA443DJ-T1-GE3
↔ SIA444DJ-T1-GE3	⊛ SIA444DJ-T1-GE3	⊣ SIA445EDJ-T1-GE3	⊛ SIA445EDJ-T1-GE3	↔ SIA447DJ-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

